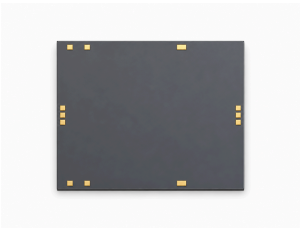
950–1250 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

LCI-PA-950-1250-PS47p5T ist ein GaN-MMIC-Leistungsverstärker als ungehäuster Chip für 950–1250 MHz. Er unterstützt CW- und Pulsbetrieb.



Kennwerte der RF-Tabelle: Sättigungsausgangsleistung: 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 60 % (typisch). RF-Prüfbedingungen: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V. Chipabmessungen: 4.35 × 3.43 × 0.1 mm.

RF-Kennwerte

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	950	-	1250	MHz
Sättigungsausgangsleistung	Psat	47	47.5	-	dBm
Leistungsverstärkung	Gp	22	22.5	-	dB
Welligkeit der Leistungsverstärkung	ΔGp	-	-	±0.3	dB
Leistungsaddierte Effizienz	PAE	-	60	-	%
Kleinsignalverstärkung	S21	-	35	-	dB
Welligkeit der Kleinsignalverstärkung	ΔS21	-	-	±1	dB
Eingangs-VSWR	VSWR(in)	-	1.6	2	-

DC-Bias und Strom

TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Drainspannung	Vd	-	28	36	V
Gatespannung	Vg	-3.2	-3	-2.8	V
Drain-Ruhestrom	Id	-	1	-	A
Dynamischer Drainstrom	Idd	-	3.5	3.8	A
Dynamischer Gatestrom	Igg	-	1	3	mA

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	Vd	-	-	36	V
Minimale Gate-Vorspannung	Vg	-5	-	-	V
Maximale Eingangsleistung	Pin	-	-	30	dBm
Maximale Kanaltemperatur	Top	-	-	225	°C

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	TSTG	-65	-	150	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	4.35 × 3.43 × 0.1	mm
Toleranz der Draufsichtkontur	±100 (Nur Draufsichtkontur; eine Dickentoleranz ist nicht angegeben.)	µm

Aktueller Publikationsstand · 1.8 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.7.

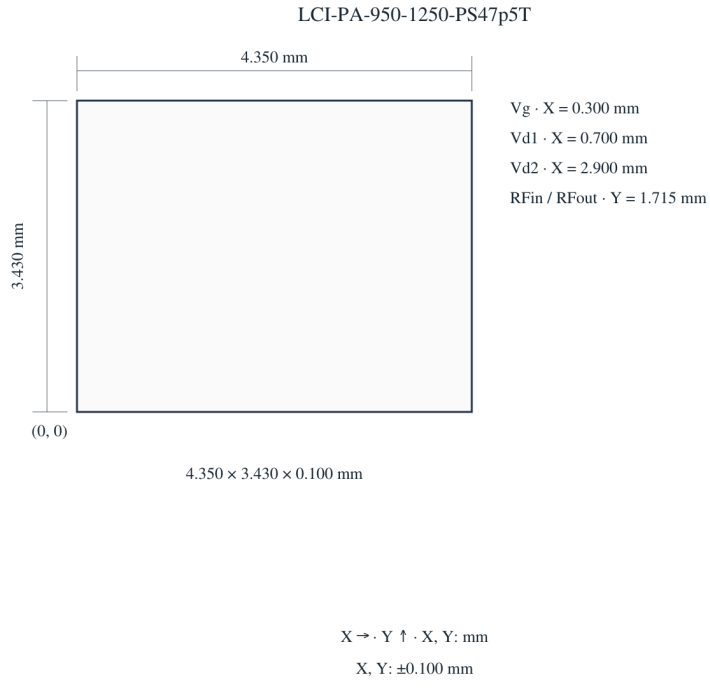
Chipintegration und Bias-Reihenfolge

Beim Einschalten zuerst die Gate-, danach die Drain-Vorspannung anlegen. Beim Ausschalten zuerst die Drain-Vorspannung entfernen. Saubere Handhabung, ESD-Schutz und ein thermisch zum SiC-Chip passender Träger sind erforderlich. Maßskizze mit Außenkontur und bemaßten Koordinaten in mm. Sie dient als Maßreferenz. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.

Bondpad-Abmessungen

RFin: 100 × 100 µm; Vg: 120 × 100 µm; Vd1: 120 × 100 µm; Vd2: 200 × 100 µm; RFout: 100 × 120 µm.

Mechanische Maßzeichnung

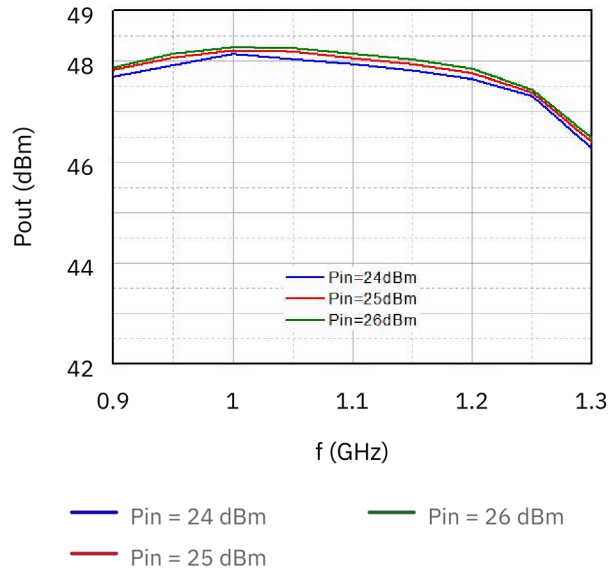


Kennlinien

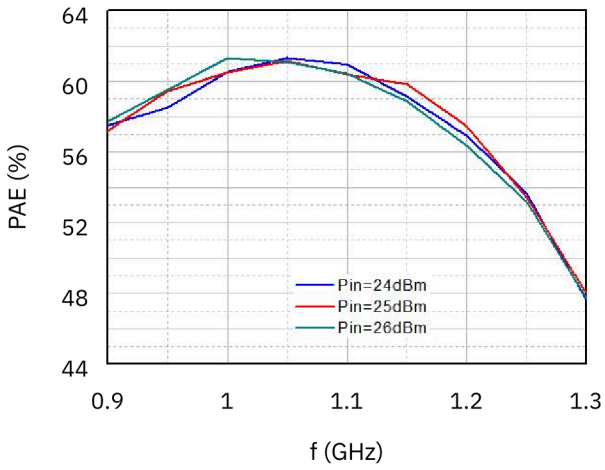
Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

Gepulst — Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom; Leistungsaddierte Effizienz (unterschiedliche Gatevorspannungen).

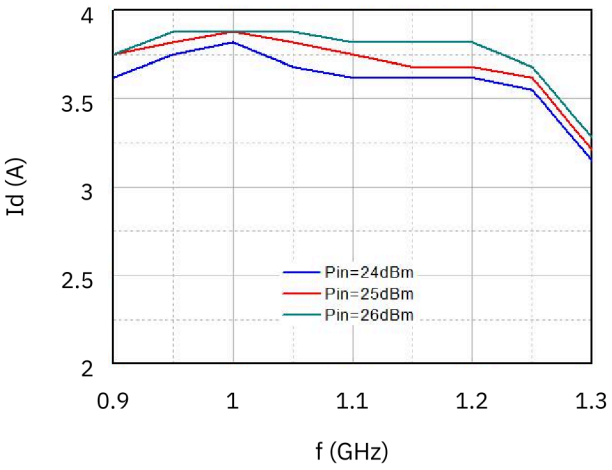
Hinweise zur Abbildung: Vd = 28 V; Vg = −2.8 V; D = 10%.



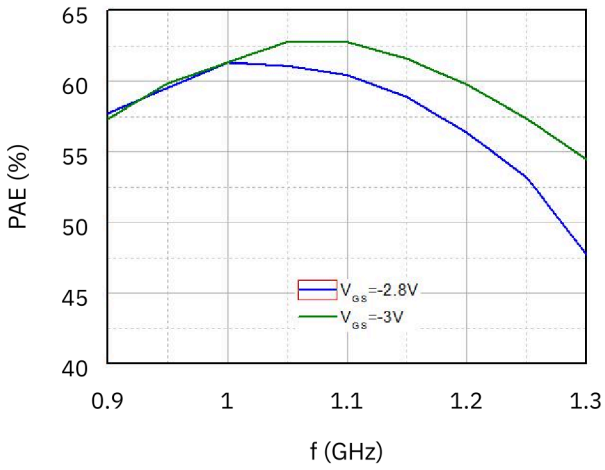
Pin = 24 dBm
Pin = 26 dBm
Pin = 25 dBm



Pin = 24 dBm
Pin = 26 dBm
Pin = 25 dBm



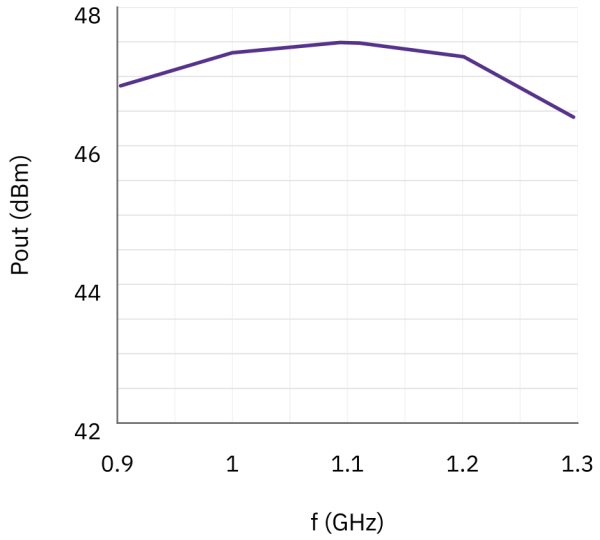
Pin = 24 dBm
Pin = 26 dBm
Pin = 25 dBm

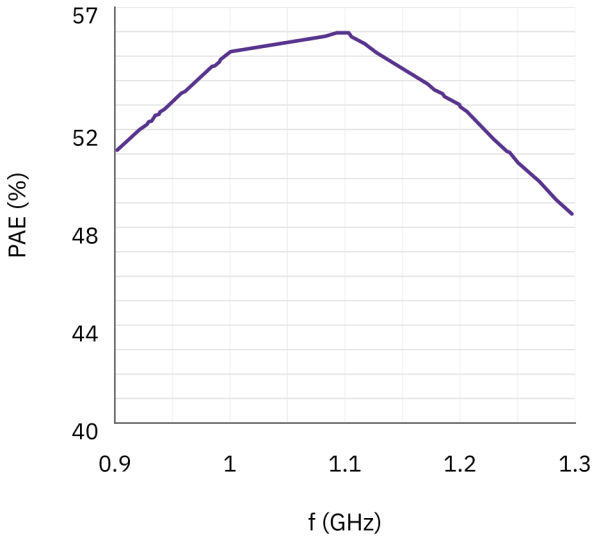


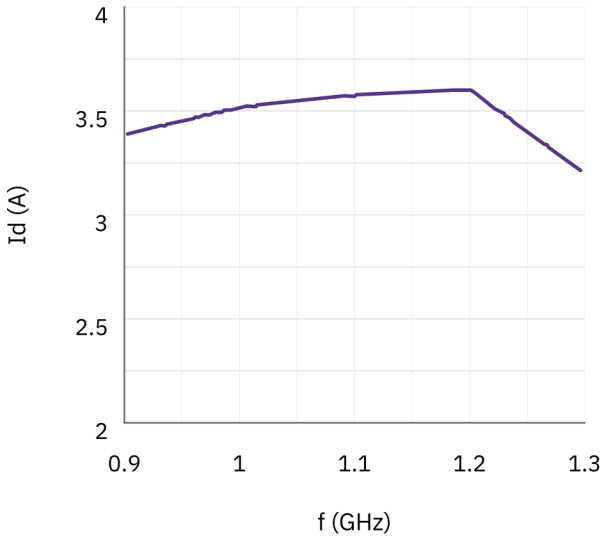
Vgs = −2.8 V
Vgs = −3 V

Dauerstrich (CW) — Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom.

Hinweise zur Abbildung: Vd = 28 V; Vg = −2.8 V. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte.







Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.